TRACKING ERROR DETECTOR OF OPTICAL HEAD

Patent Number:

JP61250844

Publication date:

1986-11-07

Inventor(s):

OSATO KIYOSHI; others: 02

Applicant(s):

SONY CORP

Requested Patent:

☐ JP61250844

Application Number: JP19850092814 19850430

Priority Number(s):

IPC Classification:

G11B7/09

EC Classification:

Equivalents:

JP2565185B2, KR9302163

Abstract

PURPOSE: To eliminate the DC fluctuation of a tracking error signal by using a beam incident part of a header part as a tilted part so that a side beam incident to the header of a semiconductor laser is reflected and not made incident again to a recording medium thereby forming the reflected beam with nearly main beam only.

CONSTITUTION: The face of the header 11 onto which the side beam via a collimator lens 2 is made incident is formed tiltedly so that its reflection beam is not made incident again in the collimator lens 2. In using not a coarse face but a mirror surface for the tilted part 11S in this case so as to avoid irregular reflection, the effect is large. Further, the reflected light of the side beam from the header 11 does not enter the collimator lens 2 by deciding the relation of thetah+thetaG-thetac>0, where thetah is an angle of the tilted part 11S to a face perpendic ular to the main beam, thetaG is an angle between the main beam and the side beam, N.Ac is the N.A of the collimator lens 2 and theta=sin<-1>NAc.

Data supplied from the esp@cenet database - I2

,		•
		•
		-

⑨ 日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭61-250844

@Int Cl.4

識別記号

厅内整理番号

匈公開 昭和61年(1986)11月7日

G 11 B 7/09

C - 7247 - 5D

審査請求 未請求 発明の数 1 (全8頁)

砂発明の名称

光学式ヘッドのトラッキング誤差検出装置

②特 願 昭60-92814

29出 願 昭60(1985)4月30日

個発 明 者 畢 大

潔

敦

東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソニー株式会社内

69発 明 者 寺 Ш 康 徳 東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソニー株式会社内

@発 明 者 福 本

東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソニー株式会社内

勿出 願 人 ソニー株式会社 東京都品川区北品川6丁目7番35号

00代 理 弁理士 伊藤 外1名

発明の名称

光学式ヘッドのトラッキング誤差 検出装置

特許請求の範囲

半導体レーザ装置と、団折格子と、ピームスプ リッタと、対物レンズと、光検出器とを有し、上 配半導体レーザ装置よりのレーザピームが上記回 折格子によりメインピーム及びその瞬側の2本の サイドピームに分けられ、この3つのピームが上 記ピームスプリッタ及び対物レンズを介して光学 式記録媒体に入射され、この光学式記録媒体から 反射されたビームが上配対物レンズを介してビー ムスプリッタに入射されて反射され、その反射ビ - ムが上記光検出器に入射され、上記 3 つのビー ムのうち少なくとも2つのピームの上記光検出器 からの検出出力を用いて上記光学式記録媒体上の 上記メインピームのトラッキング状態に応じたト ラッキングエラー信号を得るようにしたものにお いて、

上記光学式記録媒体よりの反射ビームが、上記

対物レンズ、上記ピームスプリック及び上記回折 格子を通過して上配半導体レーザ装置に戻るメイ ンピーム及びその両側のサイドピームに対してレ ーザ出射端面でのビーム反射を抑えるとともに、 上記半導体レーザ装置のヘッダ部に入射するサイ ドビームの反射ビームが上記光学系に再入射しな いように上記ヘッダ部の上記ビーム入射部分が傾 斜部とされてなる光学式ヘッドのトラッキング誤 竞校出装置。

発明の詳細な説明

以下の順序でこの発明を説明する。

- A 産業上の利用分野
- B 発明の概要
- 従来の技術
- 発明が解決しようとする問題点
- 問題点を解決するための手段
- 作用
- 実施例 (第1 図~第3 図)
- 発明の効果

A STATE OF THE PARTY OF THE PAR

			•

A 産業上の利用分野

この発明は光学式記録装置、再生装置及び記録 再生装置に使用して好適な光学式ヘッドのトラッキング誤差検出装置に関する。

B 発明の概要

3

ームし・1. L-1は光学式配録媒体 (光磁気記録媒体も含む) としての光学式ディスク(6)の記録面に所定間隔 (例えば10μα) をあけて入射する。

光学式ディスク(6)で反射された 0 次ビームし。 及び±1次ビームし・1. L-1は対物レンズ(5)を通 逝した後、ビームスプリッタ(4)に入射し、その一 邸はその反射面 (4a) で反射して光検出器(7)に入 射する。この光検出器(7)は、 0 次ビームし。及び ±1次ビームし・1. L-1が各別に入射するように される 3 個の光検出部にて構成される。

そして、いわゆる 3 スポット法と呼ばれるトラッキングエラー検出法の場合、± 1 次ピームが夫々入射する一対の光検出部からの一対の光検出出力の差を採ることにより、 0 次ピーム L。 の光学式ディスク(6)の記録面上でのトラッキング状態に応じたトラッキングエラー信号が得られる。 0 次ピームが入射した光検出部からは、再生信号、フォーカスエラー信号等が得られる。

また、この3つのビームのうち、0次ビームと その両側のサイドビームの一方あるいは3つのビ このようにすれば、光学式ディスクにスキュー があっても、トラッキングエラー信号がこのスキ ューに影響されることがなくなる。

C 従来の技術

ームのすべてを用いていわゆるアッシュブル法に よるトラッキングエラー信号の検出法を改良した 方法もある(特別昭59-215860 号参照)。

すなわち、この方法は3つのビームに対する光 検出器は分に分割したものを用いずる。そして、ック はので、かいで、なるスポットがトラットは ランドにくるす。このようによりないで、でいまりによったしておいで、それでは、 ランドに対する各光検出器の各分割師の検出、0 次ピームによるものと、ま1次ピームによるのと、 カの差の出力、すなわちず、対例レンズの積ズンシューには逆相になる。 ディスクのスキューによる各光検出器ので、 ブル出力に生じる直流変動分は同相になる。

よって 0 次ピームに対する光検出器のブッシュブル出力 PPo .と、 + 1 次又は - 1 次のピームに対する光検出器のブッシュブル出力 PPi 又は PPi との差をとれば、対物レンズの様ズレやディスクにスキューがあっても直波変動分のないトラッキン

5

「大学を表することがある。これでは、カードング・ディーのようなないできます。

		,	

グエラー信号を得ることができる。

なお、3つのブッシュブル出力を用い、PP。 - (G1 PP; + G2 PP2) なる演算によってトラッキングエラー信号を得るようにしてもよい。この場合、G1及びG2は光検出器間のゲイン巻を考慮した定数である。

次に、半導体レーザ装置(I)の一例について第5 図を診照して説明する。この半導体レーザ装置(I) は選常一方の電極を兼ねた網等の金属より成るヒ ートシンクとなるヘッグー部(8)上に固着される。

すなわち、この例ではヘッダー郎(B) はヒートシンクのみで構成されている。

半導体レーザ装置(I)のレーザチップの構造を図 においてその上層から下層に向かって説明すると、

- (Ja) は能極層、 (1b) はn-GaAs層 (基体層) 、
- (1c) は n-Gai -yAlyAs 屑 (クラッド屑) 、
- (1d) は Ga, -xAl xAs 層 (括性層) 、 (1e) は p-Ga: -yAl yAs 層 (クラッド層) 、 (1f) は p-GaAs 層である。そして、活性層 (1d) から上述のレーザビームしが出射する。この半導体レーザ装置(1)

とすると、その幅が 100~ 300μm、高さ(厚さ) が80~ 100μm、奥行が 200~ 300μm である。 活性層 (1d) のヘッダー部(B)の上面からの高さは 数μm である。

のレーザピーム出射協而 (劈開前) (1A) を正面

ところで、実際的には、3スポット法のみならず前述したような改良されたプッシュブル方式のトラッキングエラー検出法を用いた場合でも、光学式ディスクにラジアル方向のスキューがあるときには、トラッキングエラー信号に直流変動が生じてしまい、正確なトラッキングエラーを検出することができなかった。

本発明者等はその原因を究明したところ、次の ようなことが分かった。

光学式ディスク(6)で反射した 0 次ピームし。及び±1次ピームし。1、し-1 は対物レンズ(5)を通過した後、ピームスプリッタ(4)の反射面 (4a) で反射するのみならず、ピームスプリッタ(4)を通過し固折枠子(3)に入射して、失々に対応して格別の 0 次ピーム及び±1次ピームが発生し、コリメータ

7

レンズ四を通過して半導体レーザ装置川に向かう。 この半導体レーザ装置(1)に向かうビームのビーム 畳は、無偏光ビームスプリッタを用いた場合には 多く、偏光ビームスブリッタを用いた場合は少な い。この場合、半導体レーザ装置(1)のレーザビー ム出射端面 (1A) と、回折格子(3)との相対回動角 位置に応じて、半導体レーザ装置川に向かう中心 ビームしa及びその両側に位置するサイドビーム Lb. Lcの配置は第6図に示すように、夫々中 心ビームしaがレーザビーム出射端面 (1A) 上の 活性間 (!d) に位置し、両側ビームし b. L c が 中心ビームしaの位置を通り活性層 (1d) と直交 する直線上に於いて上下に位置する垂直方向に並 お場合と、中心ビームしa及び阿側ビームしb, Lcが共に活性層 (1d) 上に位置する水平方向に 並ぶ場合と、中心ビームしa及び両側ビームしb. してを結ぶ直線が上記2つの場合の中間の任意の 角度位置に来る場合とがある。 そして、これら中 心ピームしa及び両側ビームしb。 L c は、0次 ビームし。と、±1次ビームし・1、し-1が団折格

子(3)によって再回折され、且つ混在して重畳されたものである。

ところで、両側ピーム L b , L c の少なくとも一方がヘッダー部間の面に入射した場合は、その面が粗面であるので、そのピームはそこで乱反射される。一方、両側ピーム L b , L c の少なくとも一方が半導体レーザ素子(1)のレーザピーム出射協面 (1A) に入射する場合は、この協面 (1A) は反射率が良好(例えば10%)なので、この協面 (1A) で反射する。このようにレーザ装置(1)に入射した 0 次ピーム及び±1次ピームは反射され、再び回折格子(3)で回折され、ディスク(6)に速し、結局光検出器の上では複雑な干渉パターンを示す。

ここで、この干渉パターンは 0 次ピームと±1次ピームの光路長の登(位相差)によって変化する。よって、ディスク 60 のスキュー角の変化によって変化する。したがって、トラッキングエラー借号もディスクのスキュー角の変化によって変化し、例えば第7図のような周期性をもったものとなる。尚、実際には、 | α | が増大するにつれて、

	*1	

次に、以上のような干渉パターンの解析を第8 図 (レンズ系の図示を省略してある)を参照しな がら行う。

第8図において、実線にて示される(1A)はレーザビーム出射幅面であるが、破線にて示されるに見の位置の出射幅面(1A)に対し傾いている一般的な場合を示し、又、実線にて示される(6)はディスクであるが、スキューを有し、破線にてデされる正規の位置に対し側のレーザビーム出射幅(1A)及び正規の位置の光学式ディスク(6)の配録に対し鉛直である。 4 はレーザビーム出射幅面(1A)及び回折格子(3)因び光学式ディスク(6)の配長、 4 2 は回折格子(3)及び光学式ディスク(6)の配

録而間の光路長である。 Δℓ1 , Δℓ2 は失々光路長ℓ1 , ℓ2 に対する0次ビームL。及び+1次ビームL。及び+1次ビームL。間の光路差である。 Δℓ3 , Δℓ4 は失々光学式ディスク(6)のスキューによる光路差、レーザビーム山射端面(1A)のスキューによる光路差である。

又、gを国折格子(3)における 0 次ビーム L。及び+1次ビームし。間の位相差とする。i。.1:を夫々回折格子(3)における 0 次ビーム、+1次ビームの透過率、tをハーフミラー(4)の透過率、r. fを失々光学式配録媒体(6)の配録面上、レーザビーム出射婚面(1A)上の反射率とする。

+1次ビーム L+1が入射する光学式ディスク(6) の記録面上の点 A に於ける光の複素振幅を次の 4 つの場合に分けて考える。

(i) a : : + 1 次ビーム L + 1 が直接点 A に入射した 場合。

(2) a 2 : 0次ビーム L 。 が光学式ディスク(6)で反射し、再度固折格子(3)に入射することによって得られた 0次ビームがレーザビー

1 1

ム出射端間 (1A) で反射し、再度屈折格子(3)に入射することによって得られた+1次ピームが点Aに入射した場合。

(3) a n : 0 次ビーム L o が光学式ディスク(6)で反射し、再度同折格子(3)に入射することによって得られた + 1 次ビームがレーザビーム出射端面 (1A) で反射し、再度同折格子(3)に入射することによって得られた0 次ビームが点 A に入射した場合。

(4) a 、: + 1 次ビームしいが光学式ディスク(6)で 反射し、判度団折格子(3)に入射すること によって得られた 0 次ビームがレーザビ ーム出射嫡面 (1A) で反射し、再度同折 格子(3)に入射することによって得られた 0 次ビームが点 A に入射した場合。

次にaょ~aょを式にて示す。

 $a_1 = i_1 t \cdot \exp \{ j (R_1 + g + R_2 + \Delta R_2 + \Delta R_3) \}$ $\cdots (i)$

 $a_2 = 1\hat{g}_{11}t^3rf^*\exp \{j \{3 (\ell_1 + \ell_2) + g + \Delta \ell_2 + \Delta \ell_2 \}\}$

1 2

 $a_{2} = i g_{11} t^{3} r f \cdot exp \left(\right) \left(3 \left(\ell_{1} + \ell_{2} \right) + g + 2 \Delta \ell_{1} \right) + \Delta \ell_{2} + \Delta \ell_{2} + 2 \Delta \ell_{4} \right) \cdot \cdot \cdot \cdot (3)$ $a_{4} = i g_{11} t^{3} r f \cdot exp \left(\right) \left[3 \left(\ell_{1} + \ell_{2} \right) + g + 3 \left(\Delta \ell_{2} + \Delta \ell_{3} \right) + 2 \Delta \ell_{1} + 2 \Delta \ell_{4} \right] \right\}$

計算の簡単のため、レーザピームの可干渉距離を 2 (ℓ 1 + ℓ 2) 以下とすると、点Aにおける光 の強度 I A は次式のように表される。

 $I_A = |a_1|^2 + |a_2| + |a_3| + |a_4|^2$ $= |\hat{I}_1^2|^2 (1 + |\hat{I}_1^4|^2 + |\hat{I}_2^4|^2 (3 + 2\cos 2 (\Delta \ell_1 + \Delta \ell_4))$ $+ 2\cos 2 (\Delta \ell_1 + \Delta \ell_4 + \Delta \ell_2 + \Delta \ell_3) +$

2cos 2 (A & 2 + A & 2)))

又、両側ビームし b. し c の 両方がレーザビーム出射 協面 (1A) に入射する場合において、 + 1 次ピームし・1 が光学式ディスク(6) の配録面上の点 A に入射し、 - 1 次ビームし-1 が 0 次ビームし。 に対し対称な点 B に入射する場合は、点 A の光の強度 I A は(6) 式の通りであるが、点 B の光の強度 I B は次式のように要される。

 $I_B = I_1^2 t^2 (1 + I_0^2 t^4 r^2 f^2 (3 + 2\cos 2 (\Delta L_1))$

1 3

SERVICE OF THE RESIDENCE OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE

	* .

- Δ ℓ ₃) }) · · · (6

以上のようにして、光検川器の上では複雑な干渉パターンが生じるが、特に、中心ビームしょに対し、両側ビームしも、しょが垂直方向に並び、ピームしもがレーザ出射値面(1A)に、ピームしこがヘッダー部(8)に、それぞれ入射するもでもしては、というので、半導体レーザ装置(1)に戻った両側ビームしか、しょについて、変動が生じる。このにとは、にアンバランスが生じ、このためトラッと、グエラー信号に直流変動が生じる。このことは、ル法のいずれの場合も同様である。

そこで、ヘッダー部(8)側に入射するビームは乱 反射されるので光学系に戻らないであろうと考え、 レーザビーム出射磁面 (1A) 例に入射するビーム についてこれの反射を抑制する手段を施すことが

15

キングエラー信号の直流変動分を完全に除去する ことはできなかった。

B 問題点を解決するための手段

この発明においては半導体レーザ装置のレーザ 出射端所側は、そこへの関りピームの反射を抑制 する手段が施されている場合に、ヘッダー部に入 射するピームに対して、そのヘッダー部のピーム 入射部を傾斜部として反射ピームが光学系に再入 射しないようにする。

F 作用

レーザ出射端面側のみでなく、ヘッダー部側に もサイドビームの反射を抑制する手段が設けられ たので、半導体レーザ装置よりの反射ピームはほ ばメインビームのみとなり、トラッキングエラー 信号の直旋変動分は除去されるものである。

· G 実施例

第1 図はこの発明装置に用いる半導体レーザ装

考えられた。

例えば、レーザ岩子であるレーザダイオードチップを輝くしてサイドピームが戻って来てもそれが出射嫡而外になるようにしていた。

また、レーザダイオードとして高出力のものではレーザ出射端前の反射率の低いもの(例えば 2 ~ 3 %程度)が用いられているが、このようなレーザダイオードを用いて、出射端前側に関るビームの反射を抑制していた。

このように、出射端前側における関りピームの 反射の抑制の対策は描じられていたが、前述もし たようにヘッダー部については対策は講じられて いなかった。

D 発明が解決しようとする問題点

ところが、上記のようにレーザ出射値面側における関りピームの反射の抑制が十分になされると、ヘッダー部において乱反射されたものが、コリメータレンズ(2)を介し、同折格子(3)を介してディスク(6)側に戻る光の分が無視できなくなり、トラッ

16

置(I)の一例で、(10) はレーザダイオードチップ、(11) は金属からなるヘッダー部である。

(10A) はレーザ出射竭面であり、 (10d) は 活性層である。

この例においては第1図において破線の光路で示すコリメータレンズ四を介したサイドビームが入射するヘッダー部(11)の面は、図のように傾斜されてその反射ピームがコリメータレンズ(2)に再び入射しないようにする。

この場合、この例斜部 (118) は利面ではなく、 額面として乱反射をしないようにすればその効果 は大きい。

また、第2 図に示すように、この傾斜部(115) がメインビームに対して垂直な面となす角 θ_h は、 メインピームとサイドビームのなす角を θ_G 、コ リメータレンズ(2)の N. Aを NAc とし、 $\theta_C =$ sin⁻¹ NAc としたとき、

 $\theta + \theta_G - \theta_C > 0$

. . . .

となるように定めれば、ヘッダー部 (11) からの ザイドピームの反射光はコリメータレンズ(2)に入

1 8

.....

·			
•			•

射しない。

この場合に、ヘッダー郎 (11) のコリメータレ ンズ(2)との対向面の権方向の全域にわたって傾斜 部(115)を設ける必要はなく、第3関に示すよ うに、ヘッダー郎 (11) においてレーザチップ (10) の下方のサイドビームの入射部のみに傾斜 郎 (118) を有する凹部 (12) を形成するように してもよい。この場合に、この凹部 (12) の声叫 辺(12A) 及び(12B) をレーザチップ(10)を ヘッダー部 (11) 上に取り付けるときの機方向の 位置合わせ用のマーカとして用いることができる。 すなわち、両側辺 (12A) (12B) 間の距離をレ ーザチップ (10) の婚面 (10A) の幅に等しくし ておけば、レーザチップ (10) の両側を凹部 (12) の両側辺(12A) (12B) に合わせるだけで位置 合わせができる。もちろん、両側辺(12A) (12B) をともにマーカとして用いるのではなく。その一 方を位置合わせ用のマーカとするようにしてもよ w.

なお、傾斜部としては直線的なものでなく、曲

1 9

ズ、(3)は国折格子、(4)はビームスブリッタ、(5)は 対物レンズ、(6)は光学式ディスク、(10) はレー ザチップ、(8)及び(11) はヘッダー部、(115) は傾斜部である。

化 理 人 伊 鄉 貞 節

面であってもよい。

H 発明の効果

この発明によれば、サイドビームのうちヘッダー部に入射するビームの反射ビームが再び光学系に関ることがなくなるので、レーザチップの出射 歯面側においてその反射ビームを抑制するように 対策しておけば、トラッキングエラー信号のディ スクのスキューによる直流変動をより効果的に除 去することができる。

図面の簡単な説明

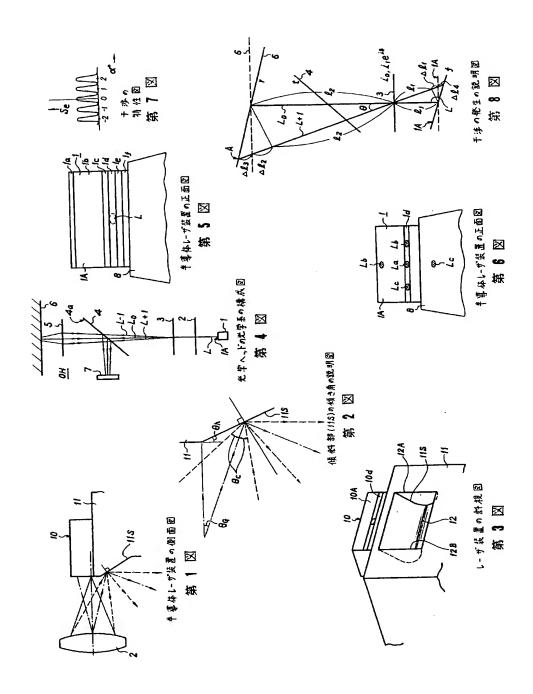
第1図はこの発明の要部の一例を示す図、第2 図はその説明のための図、第3図はその傾斜図の 一例を示す図、第4図は光学式ヘッドのトラッキング誤差検出装置の光学系の配置図の一例を示す 図、第5図~第7図はその説明のための図、第8 図は干渉の説明に供する図である。

(1) は半導体レーザ装置を全体として示し、 (1A) 及び (10A) はレーザチップのレーザビーム出射 壊面、 (1d) はその活性層、 (2) はコリメータレン

2 0

- 1. 2004年2017年,1947年,大学的基本的《大学》的《大学》(1947年)(1947年

1.			
			.*



		•
*		
	4	

手続補正書

昭和60年 5月16日

特許庁長官 志 質 学



1.事件の表示

60 - 092814

昭和60年 4月30日提出の特許願(14)

2. 発明の名称

光学式ヘッドのトラッキング観差 検出装置

3. 補正をする者

事件との関係

特許出願人

住 所 東京都品川区北品川6丁目7番35号 名 称(218)ソ ニ - 株 式 会 社 代表取締役 大 賀 典 雄

4.代 理 人

住 所 東京都新宿区西新宿1丁目8番1号 181.03-343-5821190 (新宿ビル)

氏 名 (3388) 弁理士 伊 藤 昭和60年 4月16日 5.補正命令の日付 6.補正により増加する発明の数 明細書の発明の詳細な説明の欗。 7. 補正の対象

8.補正の内容

1

平統補正書

昭和60年 6月21日

特許庁長官

適

1. 事件の表示

昭和60年 特 許 顧 第 92814号

2.発明の名称

光学式ヘッドのトラッキング誤差 検出装置

3.補正をする者

事件との関係

特許出願人

住 所 東京都品川区北品川6丁目7番35号 名 称 (2 1 8) ソ ニ - 株 式 会 社 代衷取締役 大 賀 典 雄

4.代 理 人

住 所 東京都新宿区西新宿1丁目8番1号 18L 03-343-5821何 (新宿ビル)

氏 名 (3388) 弁理士 伊 藤 昭和 年 5. 補正命令の日付

6.補正により増加する発明の数

7.補正の対象

明細書の発明の詳細な説明の風

8. 補正の内容

以中

(1) 明細暋中、20頁1行「あってもよい。」の後 に改行して下配を加入する。

「また、出射端面 (1A) の反射率が良好な場合 にはn-GaAs間 (1b) , n-Gai -yAlyAs 間 (1c) に無反射コーティングを施してもよい。」

-322--

Report to the control of the control

•
• *